

1. Record Nr.	UNINA9910821367203321
Autore	Nosaeva Ksenia
Titolo	Indium phosphide HBT in thermally optimized periphery for applications up to 300 GHz // vorgelegt von M. Eng. and Tech. Ksenia Nosaeva
Pubbl/distr/stampa	Gottingen, [Germany] : , : Cuvillier Verlag, , 2016 ©2016
ISBN	3-7369-8287-9
Edizione	[1. Auflage.]
Descrizione fisica	1 online resource (155 pages) : illustrations (some color), tables, graphs
Collana	Innovationen mit Mikrowellen und Licht. Forschungsberichte aus dem Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Hochfrequenztechnik ; ; Band 36
Disciplina	621.3815284
Soggetti	Modulation-doped field-effect transistors
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.